

高壓超流體半導體 退火系統與製程技術開發

奈盾科技股份有限公司

創立日期 109年04月

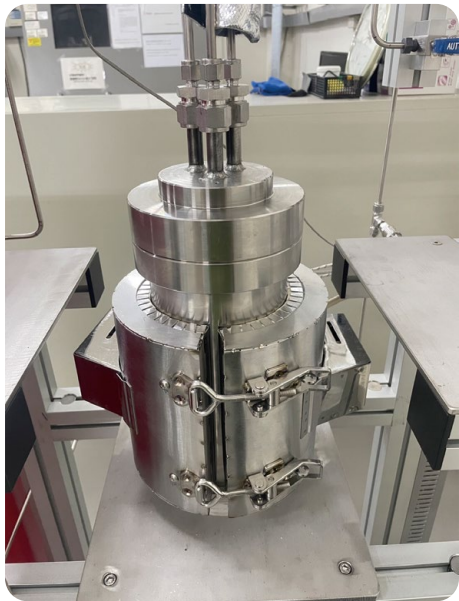
負責人 陳紀文

經營項目 半導體設備

創新動機

本計畫主要利用超臨界流體特性，開發高壓超臨界流體退火系統，最大壓力可達 200 大氣壓、最高溫度 550 攝氏度。超臨界退火技術可

應用於寬能隙半導體晶片製程並可減少寬能隙半導體中材料的缺陷問題，增進電子元件的導通能力。



重點成果

利用超臨界流體原理，發展新的退火技術，因其具有高滲透能力、高反應性的技術優勢，有潛力可以解決目前寬能隙半導體製造上的技術難點。

250 攝氏度提升至 550 攝氏度，希望能擴大應用的範圍與提升製程效果。

未來創新

擷取以高壓超流體半導體退火系統與製程技術開發為計畫主軸，在既有的技術基礎上，把製程溫度從

量化效益

- + 增加產值 7894 仟元
- + 產出新產品或服務共 1 項
- + 額外投入研發費用 1000 仟元
- + 發明專利共 3 件
- + 新型、新式樣專利共 2 件

